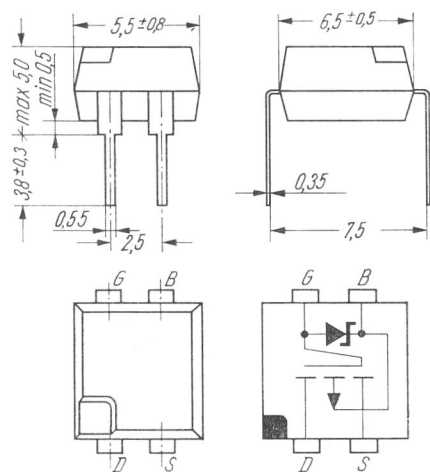


# SMY50



**Typ tranzystora:** tranzystor krzemowy

**Firma:** RFT

**Wykonanie:** tranzystor polowy MOS (kanał typu P normalnie wyłączony) ze scaloną diodą zabezpieczającą w obudowie plastikowej, połączenie płytki podłoża jest wyprowadzone na zewnątrz, ciężar około 0,3 G

**Zastosowanie:** układy cyfrowe

**Typy podobne:** MEM511 (GI)

Rys. 1-1054. SMY50

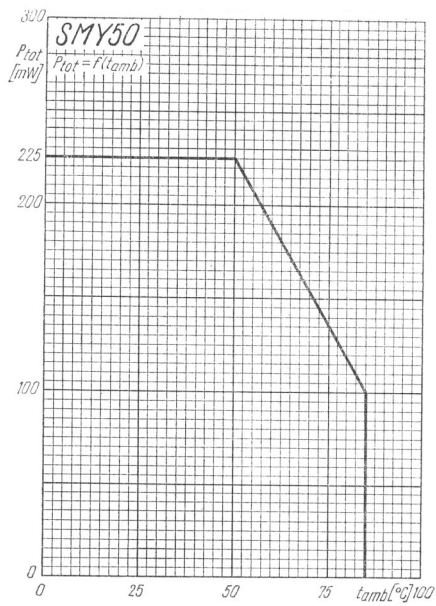
### Wartości charakterystyczne<sup>1)</sup>

	min	typ	max		
$-I_D$	3			mA	przy $-U_{DS} = 2$ V, $-U_{GS} = 10$ V, $-U_{SB} = 0$
$-I_D$		10		mA	przy $-U_{DS} = 10$ V, $-U_{GS} = 10$ V
$-U_T$	3			V	przy $U_{DS} = U_{GS}$ , $-U_{SB} = 0$ , $-I_D = 10$ $\mu$ A
$-I_{GSS}$			10	$\mu$ A	przy $-U_{DS} = 0$ , $-U_{GS} = 31$ V, $-U_{SB} = 0$
$-I_{DSS}$			0,1	$\mu$ A	przy $-U_{DS} = 0$ , $-U_{GS} = 20$ V, $-U_{SB} = 0$
$-I_{DSS}$			10	$\mu$ A	przy $-U_{DS} = 31$ V, $-U_{GS} = 0$ , $-U_{SB} = 0$
$-I_{DSS}$			0,1	$\mu$ A	przy $-U_{DS} = 20$ V, $-U_{GS} = 0$ , $-U_{SB} = 0$
$-I_{SBS}$			0,15	$\mu$ A	przy $-U_{SB} = 15$ V, $-U_{DB} = 0$ , $-U_{GB} = 0$
$-C_{gss}$			12	pF	przy $-U_{DS} = 0$ , $-U_{GS} = 0$ , $-U_{SB} = 0$
$\gamma_{21}$			3,6	mS	przy $-U_{DS} = -U_{GS} = 10$ V, $f = 1$ kHz
$R_{DS}$			150	$\Omega$	przy $-I_D = 100$ $\mu$ A, $-U_{GS} = 20$ V

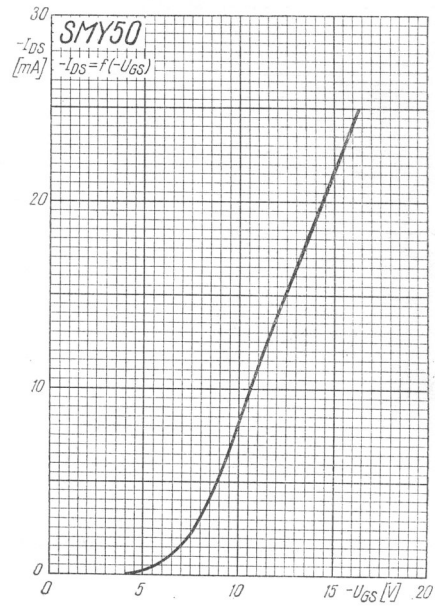
### Wartości graniczne

$-U_{DS}$ max	31 ÷ -0,3	V	$-I_D$ max	25	mA
$-U_{GS}$ max	31 ÷ -0,3	V	$I_G$ max	0,1	mA
$-U_{DG}$ max	31 ÷ -31	V	$I_{GSM}$ max	2	mA
$-U_{SB}$ max	15 ÷ -0,3	V	$P_{tot}$ max	225 <sup>1)</sup>	mW
$-U_{GB}$ max	31 ÷ -0,3	V	$t_{stg}$	-40 ÷ +125	°C
$-U_{DB}$ max	31 ÷ -0,3	V	$t_{amb}$	-25 ÷ +85	°C

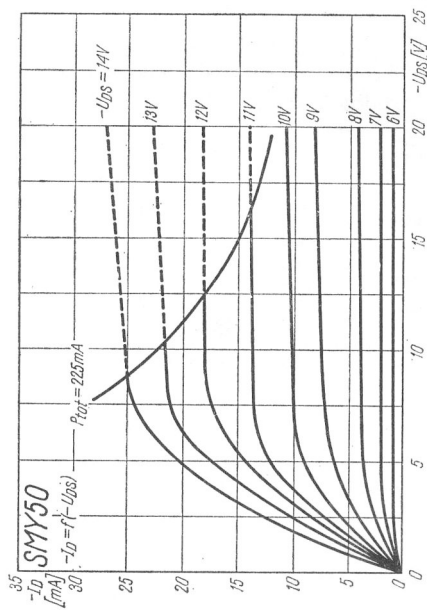
<sup>1)</sup>  $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$



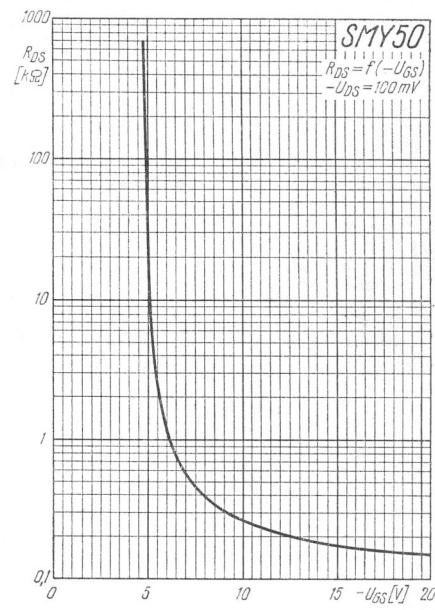
Rys. 1-1055. Zależność dopuszczalnej mocy strat od temperatury otoczenia



Rys. 1-1056. Charakterystyka wejściowa



Rys. 1-1057. Charakterystyki wyjściowe



Rys. 1-1058. Zależność rezystancji  $R_{DS}$  od napięcia bramki